



РФЯЦ-ВНИИТФ  
РОСАТОМ

# Расчёты скорости обмена энергией между электронами и ионами на основе модели среднего атома Старретта и Саумона

А.А. Овечкин, Н.А. Смирнов, П.А. Лобода, А.Л. Фальков

РФЯЦ – ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина

# Релаксация импульса и энергии электронов в твёрдом теле и в жидкости/плазме



РФЯЦ-ВНИИТФ  
РОСАТОМ

↓  
Электропроводность,  
теплопроводность

↘  
Выравнивание температуры в  
неравновесно нагретом веществе

$$\frac{\partial E_e}{\partial t} = -G (T_e - T_i)$$

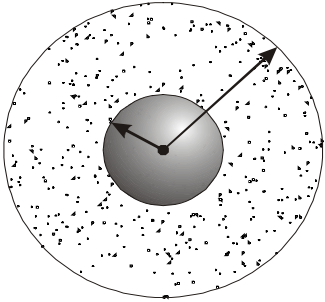
↗  
коэффициент электрон-фононного/электрон-ионного обмена

- Взаимодействие лазерного излучения с веществом:  $T_e > T_i$
- Термоядерный синтез:  $T_i > T_e$

# Модели среднего атома



РФЯЦ-ВНИИФ  
РОСАТОМ



- Приближение сферической симметрии
- Приближение самосогласованного поля

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V(r) \right) \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r})$$

$$V(r) = V_{\text{el}}(r) + V_{\text{xc}}(r)$$

$$\nabla^2 V_{\text{el}}(r) = -4\pi e^2 (n_e(r) - n_i(r))$$

$$n_e(r) = \sum_i f(\varepsilon_i) |\psi_i(\mathbf{r})|^2$$

- Статистика Ферми-Дирака


$$f(\varepsilon) = \{1 + \exp [\beta_e (\varepsilon - \mu_e)]\}^{-1}, \quad \beta_e = 1/T_e$$

**Модели применимы в широком диапазоне  $T$  и  $\rho$ , охватывающем состояния горячего и тёплого плотного вещества**

# Коэффициент электрон-фононного обмена в твёрдом теле. Обобщённый метод Аллена [1,2]



РФЯЦ-ВНИИТФ  
РОСАТОМ

$T_e > \theta_D$  ( $\theta_D$  – температура Дебая)  рассеяние электронов можно считать упругим

$$T_i > \theta_D$$

$$G = \pi \hbar \beta_e n_i \int P^{(1)}(\varepsilon) f(\varepsilon, \mu_e) [1 - f(\varepsilon, \mu_e)] d\varepsilon$$

$$P^{(1)}(\varepsilon) = \frac{4}{\hbar} \sum_{\mathbf{k}, i; \mathbf{k}', j; \nu} \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu} \delta(\varepsilon_{\mathbf{k}, i} - \varepsilon) \delta(\varepsilon_{\mathbf{k}', j} - \varepsilon) \left| \mathcal{G}_{\mathbf{k}, i; \mathbf{k}', j}^{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu} \right|^2$$

$\mathbf{K} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$  – приращение волнового вектора электрона,  $n_i$  – средняя концентрация ионов

$\mathbf{q}(\mathbf{K}) = \mathbf{K} - \mathbf{g}$  – волновой вектор фонона, приведённый к 1-й зоне Бриллюэна

$\mathbf{g}$  – вектор обратной решётки

$\nu, \omega_{\mathbf{q}, \nu}$  – поляризация и частота фонона

$\mathcal{G}_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'}^{\mathbf{q}, \nu}$  – матричный элемент электрон-фононного взаимодействия

# Коэффициент электрон-фононного обмена в твёрдом теле.

## Обобщённый метод Аллена [1,2]



РФЯЦ-ВНИИФ  
РОСАТОМ

Маффин-тин приближение

$$V_e(r) = \begin{cases} V(|\mathbf{r} - \mathbf{R}_i|) & \text{при } |\mathbf{r} - \mathbf{R}_i| \leq a, \\ 0 & \text{при } \min_j |\mathbf{r} - \mathbf{R}_j| > a. \end{cases}$$



В случае одного  
рассеивающего центра [3]

$$P^{(1)}(\varepsilon) = \frac{4m_e^2 \varepsilon^2 \sigma_{\text{tr}}^{(1)}(\varepsilon)}{\pi^3 \hbar^4 M_i}$$

транспортное сечение e-i рассеяния в сферически-симметричном потенциале  $V(r)$   $\longrightarrow$   $\sigma_{\text{tr}}^{(1)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega} = \frac{2\pi \hbar^2}{m_e \varepsilon} \sum_{l=0}^{\infty} \sin^2(\delta_{l+1}(\varepsilon) - \delta_l(\varepsilon))$

### Формула (1)

- может использоваться для расчётов коэффициента электрон-ионного обмена в плазме на основе моделей среднего атома
- была ранее получена при помощи
  - соотношения Кубо [4]
  - квантового кинетического уравнения Больцмана [5]



$$G = 3\bar{Z} n_i m_e \nu_{ei}^{(1)} / M_i \quad (1)$$

$$\nu_{ei}^{(1)} = \frac{4m_e \beta_e}{3\pi^2 \hbar^3 \bar{Z}} \int_0^{\infty} \varepsilon^2 f(\varepsilon) [1 - f(\varepsilon)] \sigma_{\text{tr}}^{(1)}(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$\bar{Z} = \frac{\sqrt{2} m_e^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3 \beta_e^{3/2} n_i} I_{1/2}(\beta_e \mu_e), \quad I_k(x) = \int_0^{\infty} \frac{y^k dy}{1 + \exp(y - x)}$$

↑  
средний заряд иона

1. P.B. Allen. Phys. Rev. Lett. **59**, 1460 – 1463 (1987).
2. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B **101**, 094103 (2020).
3. G.D. Gaspari, B.L. Gyorffy. Phys. Rev. Lett. **28**, 801 – 805 (1972).
4. J. Daligault, J. Simoni. Phys. Rev. E **100**, 043201 (2019).
5. S. Rightley, S.D. Baalrud. Phys. Rev. E **103**, 063206 (2021).

**Коэффициент электрон-фононного обмена в твёрдом теле (обобщённый метод Аллена)**



**Приближение сферической симметрии**



**Коэффициент электрон-ионного обмена в плазме на основе модели среднего атома**

**Можно получить согласованные широкодиапазонные зависимости  $G(\rho, T_e, T_i)$ , используя результаты твердотельных расчётов при низких  $T_e, T_i$  (до нескольких эВ) и расчётов по моделям среднего атома при более высоких  $T_e, T_i$**

# Удельное электрическое сопротивление в твёрдом теле. Метод Аллена для решения уравнения Больцмана [1,2]



РФЯЦ-ВНИИФ  
РОСАТОМ

$T_e > \theta_D$   рассеяние электронов можно считать упругим

$$\eta = \frac{3\pi \hbar M_i \beta_e}{e^2 m_e^2 n_i} \int d\varepsilon \frac{f(\varepsilon) [1 - f(\varepsilon)] P^{(2)}(\varepsilon)}{[w(\varepsilon) v^2(\varepsilon)]^2}$$

$$P^{(2)}(\varepsilon) = \frac{4}{\hbar} \sum_{\mathbf{k}, i; \mathbf{k}', j; \nu} \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu} \delta(\varepsilon_{\mathbf{k}, i} - \varepsilon) \delta(\varepsilon_{\mathbf{k}', j} - \varepsilon) \left| \mathcal{G}_{\mathbf{k}, i; \mathbf{k}', j}^{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu} \right|^2 S_{ii}^{(1)}(K)$$

$$S_{ii}^{(1)}(K) = \frac{\hbar K^2 [2n_B(\beta_i \hbar \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu}) + 1]}{2M_i \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu}} \approx \frac{\hbar}{2M_i} \sum_{\nu'} \frac{(\mathbf{K} \mathbf{e}_{\nu'})^2}{\omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu'}} [2n_B(\beta_i \hbar \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}), \nu'}) + 1]$$

$n_B(x) = [\exp(x) - 1]^{-1}$ ,  $\beta_i = 1/T_i$ ,  $w(\varepsilon)$  – плотность состояний электронов

$S_{ii}^{(1)}(K)$  – эффективный ион-ионный структурный фактор (без учёта слагаемого, отвечающего брэгговскому рассеянию), в однофононном приближении

1. P.B. Allen. Phys. Rev. B **17**, 3725 – 3734 (1978).
2. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B **106**, 024109 (2022).
3. D.A. Baiko, A.D. Kaminker, A.Y. Potekhin, D.G. Yakovlev. Phys. Rev. Lett. **81**, 5556 – 5559 (1998).

# Удельное электрическое сопротивление в твёрдом теле. Метод Аллена для решения уравнения Больцмана [1,2]



РФЯЦ-ВНИИФ  
РОСАТОМ

- Приближение однородного газа свободных электронов

$$w(\varepsilon) = \sqrt{2\varepsilon} m_e^{3/2} / (\pi^2 \hbar^3 n_i), \quad v(\varepsilon) = \sqrt{2m_e \varepsilon}$$

- Случай сильного вырождения электронов

$$T_e \lesssim E_F \Rightarrow \varepsilon \approx \mu_e, \quad w(\varepsilon) v^2(\varepsilon) \approx 3\bar{Z}/m_e$$

- Маффин-тин приближение + один рассеивающий центр [3]

$P^{(2)}(\varepsilon)$  отличается от  $P^{(1)}(\varepsilon)$  в выражении для  $G$  только наличием под знаком суммы множителя  $S^{(1)}(K)$

$$P^{(2)}(\varepsilon) = \frac{4m_e^2 \varepsilon^2 \sigma_{\text{tr}}^{(2)}(\varepsilon)}{\pi^3 \hbar^4 M_i}, \quad \sigma_{\text{tr}}^{(2)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) S_{ii}^{(1)}(K) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega}, \quad K = 2\sqrt{m_e \varepsilon (1 - \cos \theta)}/\hbar$$

$$\eta = \frac{m_e \nu_{ei}^{(2)}}{\bar{Z} n_i e^2}, \quad \nu_{ei}^{(2)} = \frac{4m_e \beta_e}{3\pi^2 \hbar^3 \bar{Z}} \int_0^\infty \varepsilon^2 f(\varepsilon) [1 - f(\varepsilon)] \sigma_{\text{tr}}^{(2)}(\varepsilon) d\varepsilon$$

**Обобщённая формула  
Займана (используется  
в расчётах по моделям  
среднего атома [4])**

1. P.B. Allen. Phys. Rev. B **17**, 3725 – 3734 (1978).
2. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B **106**, 024109 (2022).
3. G.D. Gaspari, B.L. Gyorffy. Phys. Rev. Lett. **28**, 801 – 805 (1972).
4. P.A. Sterne, S.B. Hansen, B.G. Wilson, W.A. Isaacs. HEDP **3**, 278 – 282 (2007).



# Методы расчёта коэффициента электрон-фононного обмена и электрического сопротивления в твёрдом теле

Приближение сферической симметрии

Методы расчёта

коэффициента электрон-ионного обмена и электрического сопротивления  
в плазме на основе модели среднего атома

$$G = 3\bar{Z} n_i m_e \nu_{ei}^{(1)} / M_i$$

$$\eta = m_e \nu_{ei}^{(2)} / (\bar{Z} n_i e^2)$$

$$\nu_{ei}^{(1,2)} = \frac{4m_e \beta_e}{3\pi^2 \hbar^3 \bar{Z}} \int_0^\infty \varepsilon^2 f(\varepsilon) [1 - f(\varepsilon)] \sigma_{tr}^{(1,2)}(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$\sigma_{tr}^{(1)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega}$$

$$\sigma_{tr}^{(2)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) S(K) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega}$$

**Нет ионного структурного фактора**  
(описывает передачу энергии, не связанную с макроскопическим потоком частиц; направление движения рассеянного электрона не играет роли)

**Есть ионный структурный фактор**  
(описывает релаксацию импульса, не связанную с макроскопическим потоком электронов; направление движения рассеянного электрона играет роль)

# Двухтемпературная модель среднего атома Старретта и Саумона [1,2]



РФЯЦ-ВНИИФ  
РОСАТОМ

- Вещество – совокупность псевдоатомов
- Псевдоатом: ион (центральное ядро + связанные электроны) и экранирующие его свободные электроны

## Рассеивающий потенциал

Потенциал  $V^{PA}(r)$ , создаваемый отдельным псевдоатомом

- Слабо зависит от  $T_i$ , что согласуется с обобщённым формализмом Аллена для твёрдого тела и с диэлектрическим формализмом Далиго и Димонте [3]

Потенциал  $V^{MF}(r)$ , создаваемый совокупностью всех псевдоатомов [4]

- Более чувствителен к  $T_i$ , чем  $V^{PA}(r)$

**Какой потенциал правильнее использовать?**

1. C.E. Starrett, D. Saumon. HEDP 10, 35 – 42 (2014).
2. Z.A. Johnson, N. Shaffer, M.S. Murillo. arXiv:2411.02363v1 (2024).
3. J. Daligault, G. Dimonte. Phys. Rev. E 79, 056403 (2009).
4. C.E. Starrett. HEDP 25, 8 – 14 (2017).

# Диэлектрический формализм Далиго и Димонте для коэффициента электрон-ионного обмена [1]



РФЯЦ-ВНИИФ  
РОСАТОМ

$$G = 3 \langle Z \rangle n_i m_e \nu_{ei} / M_i, \quad \nu_{ei} = 4 \sqrt{2\pi} \langle Z \rangle^2 e^4 n_i \ln \Lambda / (3 \sqrt{m_e} T_e^{3/2})$$

$$\ln \Lambda = \frac{\sqrt{\pi}}{2 \langle Z \rangle I_{1/2}(\beta_e \mu_e)} \int_0^\infty dk \frac{\tilde{n}_e^{\text{scr}}(k)}{\kappa^2 [k^2 + \kappa^2 (1 - G_{ee}(k))]} f\left(\frac{\hbar^2 k^2}{8m_e}\right)$$

$$\tilde{n}_e^{\text{scr}}(k) = \frac{4\pi}{k} \int_0^\infty r n_e^{\text{scr}}(r) \sin(kr) dr, \quad n_e^{\text{scr}}(r) - \text{плотность свободных электронов псевдоатома}$$

$G_{ee}(k)$  – локальная электрон-электронная полевая поправка [2]

$\kappa^2 = -4\pi e^2 \chi_e^0(k)$ ,  $\chi_e^0(k)$  – статическая функция отклика невзаимодействующих электронов [3]

$$\langle Z \rangle = 4\pi \int_0^\infty n_e^{\text{scr}}(r) r^2 dr - \text{средний заряд иона (при высоких } T_e \text{ } \langle Z \rangle \approx \bar{Z})$$

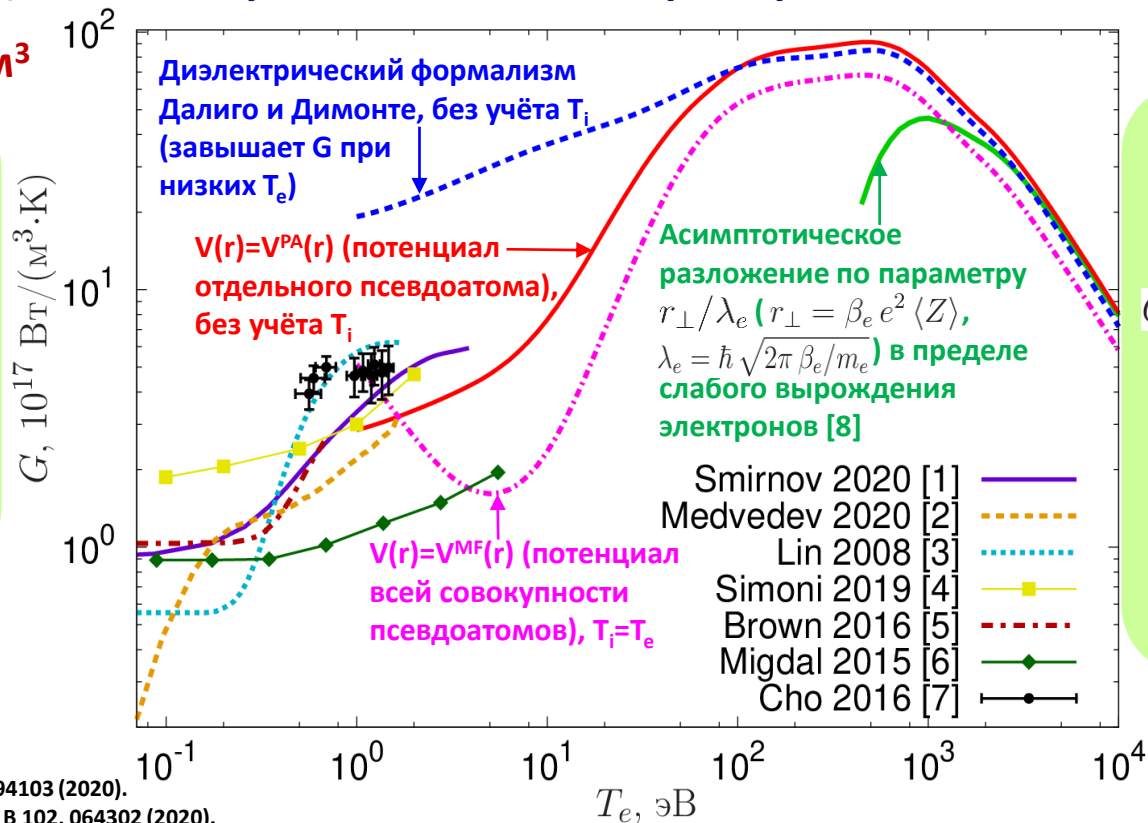
**Модель Старретта и Саумона обеспечивает все необходимые входные величины**

1. J. Daligault, G. Dimonte. Phys. Rev. E **79**, 056403 (2009).
2. S. Ichimaru, K. Utsumi. Phys. Rev. B **24**, 7385 – 7388 (1981).
3. G. Chabrier. J. Phys. France **51**, 1607 – 1632 (1990).

# Коэффициент электрон-ионного/электрон-фононного обмена в меди

$\rho = 8.92 \text{ г/см}^3$

Сравнение с результатами многоцентровых расчётов не позволяет однозначно отдать предпочтение  $V^{\text{PA}}(r)$  или  $V^{\text{MF}}(r)$



РФЯЦ-ВНИИФ  
РОСАТОМ

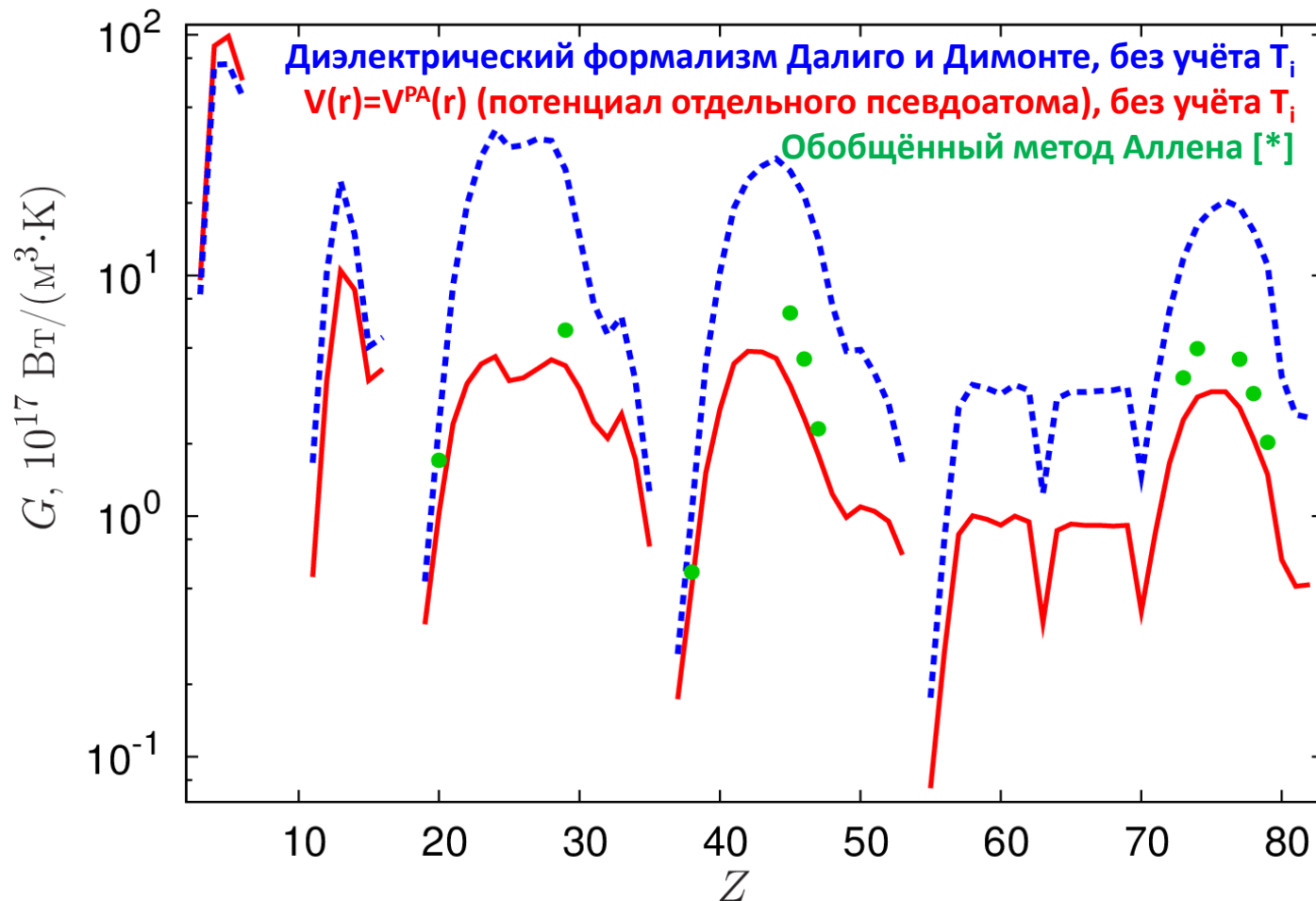
$V^{\text{PA}}(r)$  обеспечивает более точную асимптотику  $G \propto \ln r_{\text{De}}$  ( $r_{\text{De}}$  – электронный дебаевский радиус), чем  $V^{\text{MF}}(r)$  ( $G \propto \ln r_D$ ,  $r_D$  – полный дебаевский радиус)

1. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B **101**, 094103 (2020).
2. N. Medvedev, I. Milov. Phys. Rev. B **102**, 064302 (2020).
3. Z. Lin, L.V. Zhitilei, V. Celli. Phys. Rev. B **77**, 075133 (2008).
4. J. Simoni, J. Daligault. Phys. Rev. Lett. **122**, 205001 (2019).
5. A.M. Brown, R. Sundararaman, P. Narang, W.A. Goddard, H.A. Atwater. Phys. Rev. B **94**, 075120 (2016).
6. K.P. Migdal, D.K. Il'nitsky, Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov. J. Phys.: Conf. Ser. **653**, 012086 (2015).
7. B.I. Cho, T. Ogitsu, K. Engelhorn *et al.* Sci. Rep. **6**, 18843 (2016).
8. L.S. Brown, R.L. Singleton. Phys. Rev. E **76**, 066404 (2007).

# Зависимость $G(Z)$ при $\rho=\rho_0$ , $T_e=45$ кК (3.88 эВ)



РФЯЦ-ВНИИТФ  
РОСАТОМ





- Какой рассеивающий потенциал следует использовать в расчётах коэффициента электрон-ионного обмена и электропроводности/теплопроводности на основе моделей среднего атома?
- Как выйти за рамки приближения однородного электронного газа и/или как правильно определить средний заряд иона в формуле Займана?
- Качественная и количественная зависимость коэффициента электрон-ионного/электрон-фононного обмена от температуры ионов.

- Показано, что разработанные Алленом методы расчёта коэффициента электрон-фононного обмена и электропроводности в частном случае сферического электронного потенциала согласуются с методами, которые были развиты применительно к моделям среднего атома. При этом транспортное сечение рассеяния электрона в потенциале среднего атома при расчёте электропроводности должно вычисляться с учётом ионного структурного фактора, а при расчёте коэффициента электрон-ионного обмена – без учёта структурного фактора.

- Применительно к расчётам коэффициента электрон-ионного обмена протестированы два способа вычисления рассеивающего потенциала на основе модели среднего атома Старретта и Саумона. Показано, что оба способа дают в целом близкую степень согласия с результатами многоцентровых расчётов при температурах электронов порядка нескольких эВ, но при этом расчёт сечения рассеяния в потенциала отдельного псевдоатома обеспечивает более точную высокотемпературную асимптотику по сравнению с потенциалом, создаваемым всей совокупностью псевдоатомов. Альтернативный способ расчёта коэффициента электрон-ионного обмена при помощи диэлектрического формализма Далиго и Димонте, адаптированного к модели Старретта и Саумона, систематически завышает результаты при  $T_e < 10 - 100$  эВ.